

# 半导体学报

第2卷 第3期 1981年8月

## 目 录

用深能级瞬态谱及瞬态电容研究靠近禁带中央能级的新方法.....  
 .....秦国刚 张玉峰 杜永昌 吴书祥 张丽珠 陈开茅 (169)

亚微米砷化镓气相双层外延与高阻缓冲层.....王永晨 朱毅敏 (182)

GaAs-Ga<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>As 双异质结激光器的深能级荧光.....  
 .....王守武 王仲明 许继宗 (189)

半导体激光器传输特性的理论分析.....单永政 杜宝勋 (197)

质子轰击条形 InGaAsP/InP 双异质结激光器 .....  
 .....朱龙德 张盛廉 汪孝杰 王 莉 高淑芬及七室器件工艺组 (212)

正向势垒电容的异常变化及其在参放变容管中的应用.....江关辉 (222)

## 研究简报

脉冲电子束退火装置及其对注砷硅的退火结果.....  
 .....伊藤纠次 饶德祥 田村英男 大久保靖 (234)

用热激电流法测定硅-二氧化硅的界面态 .....盛 麓 (240)

III-V 族半导体材料的低温光致发光 .....  
 .....于 鲲 孟庆惠 李永康 吴灵犀 陈廷杰 徐寿定 (243)

## 会议简讯

四面体键无定形半导体国际会议简讯.....陈坤基 (247)

### 本刊第二卷第二期勘误

页	行	误	正
118	8	(16)	(1b)
119		此页中所有 $\nu$ 均为 $\sigma$ 例如	
	12	$B_0(\nu), B_r(\nu)$ 和 $B_S(\nu)$	$B_0(\sigma), B_r(\sigma)$ 和 $B_S(\sigma)$
137	1	(5)	(3)
151	14	$I_C, R_C, R_B, \beta_F$ 和 $\beta_R$	$I_{SRS}, I_C, R_C, R_B$ 和 $\beta_F$
152	6	$T_S$	$t_S$